

# 半导体学报

第 10 卷 第 4 期 1989 年 4 月

## 目 录

- TiN/n-GaAs 肖特基势垒特性.....张利春 高玉芝 (241)
- MOS 型波导光学特性分析.....马春生 刘式墉 (249)
- 半导体多量子阱激光器的波导模式分析.....郭长志 杨新民 (254)
- 条形 DH 半导体激光器的自发发射因子.....赵一广 郭长志 (264)
- 单晶硅中磷离子注入缺陷的 HREM 研究.....  
.....严勇 李齐 冯端 孙慧龄 王培大 (276)
- 激光等离子体淀积硅薄膜过程动力学研究.....  
.....董丽芳 傅广生 李晓菁 韩理 张连水 吕福润 (280)
- 集成电路中多晶硅薄膜载流子迁移率的实验研究和理论模型.....  
.....王阳元 陶江 韩汝琦 吉利久 张爱珍 (286)
- 快速热工艺氧化法生长超薄 SiO<sub>2</sub> 层的研究.....黄宜平 C. A. Paz de Araujo (294)
- In-Ga 合金源汽相外延生长 In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As 体系的热力学分析.....  
.....徐宝琨 李钟华 宋利珠 赵慕愚 (301)

## 研究简报

- Si<sup>+</sup>, Mg<sup>+</sup> (隐埋) 双注入 GaAs MESFET...欧海疆 王渭源 赵崎华 蒋新元 (309)
- 光电化学法测定硅中少子扩散长度.....骆茂民 彭瑞伍 (313)

## 研究快报

- In<sub>x</sub>Ga<sub>1-x</sub>As/GaAs 应变单量子阱结构的静压光致发光研究.....  
...李国华 郑宝真 韩和相 汪兆平 T. G. Andersson and Z. G. Chen (317)